

УДК 539.124:539.292.01

Ф. А. Живописцев
Ф. Э. КомасМНОГОЭЛЕКТРОННЫЕ ЭФФЕКТЫ
В СПЕКТРАХ НЕУПРУГОГО РАССЕЯНИЯ
БЫСТРЫХ ЭЛЕКТРОНОВ
В МЕТАЛЛАХ (I)

Изучается процесс неупругого рассеяния электронов в металлах (e, e'). Показано, что динамический форм-фактор, учитывающий переход электрона с атомного уровня на поверхность Ферми, выражается через двухчастичную функцию Грина (в канале электрон зоны проводимости — внутренняя дырка), при этом выражение для динамического форм-фактора справедливо по всему диапазону частот спектра (не только у края поглощения).

В последнее время был выполнен ряд работ [1—4], посвященных исследованию поведения рентгеновских спектров металлов у коротковолнового края (спектры эмиссии) и у края поглощения (спектры поглощения), т. е. в тех случаях, когда электрон переходит с поверхности Ферми на атомный уровень либо выбрасывается с атомного уровня на поверхность Ферми. При учете взаимодействия электронов с дыркой на атомном уровне (внутренней дыркой) было обнаружено, что амплитуда перехода электрона с поверхности или на поверхность Ферми имеет особенность. Эта особенность появляется вследствие учета многоэлектронных эффектов и указывает на нетривиальный характер влияния этих эффектов на рентгеновские спектры. В этой связи особый интерес приобретают эксперименты по неупругому рассеянию электронов в металлах [5—7].

В настоящей работе изучается процесс неупругого рассеяния электронов в металлах (e, e'). Показано, что динамический форм-фактор (ДФФ) выражается через двухчастичную функцию Грина; основная часть ДФФ, учитывающего переход электрона с атомного уровня на поверхность Ферми, выражается через двухчастичную функцию Грина (в канале электрон — внутренняя дырка). При этом выражение для ДФФ справедливо по всему диапазону спектра (не только у края поглощения).

Динамический форм-фактор (e, e'). В первом порядке нестационарной теории возмущений вероятность того, что в единицу времени быстрый (внешний) электрон передаст импульс \mathbf{q} и энергию ω , записывается в виде [8—10]

$$W(\mathbf{q}, \omega) = 2\pi \left(\frac{4\pi e^2}{q^2} \right)^2 \sum_s |\langle s | \rho_{\mathbf{q}}^{\dagger} | 0 \rangle|^2 \delta(\omega - \omega_{s0}), \quad (1)$$

где $\rho_{\mathbf{q}}$ — оператор флуктуации плотности частиц, $|s\rangle$ — возбужденное состояние системы, $|0\rangle$ — основное состояние, $\omega_{s0} = \epsilon_s - \epsilon_0$ — энергия возбуждения:

$$\omega_{s0} = \omega = \frac{1}{m} \left(\mathbf{p}\mathbf{q} - \frac{1}{2} q^2 \right), \quad (2)$$

где \mathbf{p} — начальный импульс внешнего электрона, $|\mathbf{q}| = q$.

Величина передаваемого импульса q определяется соотношением

$$q^2 = 2p^2 \left[1 - \left| 1 - \frac{\omega}{E} \right|^{1/2} \cos \theta - \frac{\omega}{2E} \right], \quad (3)$$

где $E = \frac{1}{2m} p^2$, θ — угол рассеяния (угол между \mathbf{q} и $\mathbf{p}-\mathbf{q}$). Если $\omega \ll E$, то для q получим

$$q \simeq 2p \left(1 - \frac{\omega}{4E} \right) \sin \frac{\theta}{2}. \quad (4)$$

В этом приближении q практически от ω не зависит для всех интересных значений ω (при $\frac{\omega}{4E} \ll 1$). ДФФ определяется следующим соотношением:

$$S(\mathbf{q}, \omega) = \sum_s |\langle s | \rho_{\mathbf{q}}^{\dagger} | 0 \rangle|^2 \delta(\omega - \omega_{s0}). \quad (5)$$

Легко показать, что выражение (5) для $S(\mathbf{q}, \omega)$ можно представить в виде

$$S(\mathbf{q}, \omega) = \frac{1}{\pi} \operatorname{Re} \int_0^{\infty} dt \exp(i\omega t) \Pi(\mathbf{q}, t), \quad (6)$$

где $\Pi(\mathbf{q}, t) = \langle 0 | \rho_{\mathbf{q}}(t) \rho_{\mathbf{q}}^{\dagger}(0) | 0 \rangle$ — корреляционная функция. Общее выражение для оператора флуктуации плотности $\rho_{\mathbf{q}}$ имеет вид

$$\begin{aligned} \rho_{\mathbf{q}} = & \sum_{\mathbf{p}} M_{\mathbf{p}}(\mathbf{q}) a_{\mathbf{p}}^{\dagger} b + \sum_{\mathbf{p}} M_{\mathbf{p}}^*(-\mathbf{q}) b^{\dagger} a_{\mathbf{p}} + \\ & + \int d^3x \exp(-i\mathbf{q}\mathbf{x}) |\Phi(\mathbf{x})|^2 d^3x b^{\dagger} b + \\ & + \sum_{\mathbf{p}, \mathbf{p}'} \int d^3x \exp(-i\mathbf{q}\mathbf{x}) \psi_{\mathbf{p}}^*(\mathbf{x}) \psi_{\mathbf{p}'}(\mathbf{x}) a_{\mathbf{p}}^{\dagger} a_{\mathbf{p}'}, \end{aligned} \quad (7)$$

где

$$M_{\mathbf{p}}(\mathbf{q}) = \int d^3x \exp(-i\mathbf{q}\mathbf{x}) \psi_{\mathbf{p}}^*(\mathbf{x}) \Phi(\mathbf{x}), \quad (8)$$

$\psi_{\mathbf{p}}(\mathbf{x})$ — волновая функция электрона зоны проводимости, $\Phi(\mathbf{x})$ — волновая функция внутреннего электрона (на атомном уровне); $a_{\mathbf{p}}, a_{\mathbf{p}}^{\dagger}$ — операторы уничтожения и рождения электронов зоны проводимости; b, b^{\dagger} — операторы уничтожения и рождения внутреннего электрона соответственно.

Для простоты рассмотрения процесса неупругого рассеяния (e, e'), когда выбивается сильносвязанный электрон из заполненной внутренней оболочки атома в металл, предположим, что а) внутренняя дырка не размножается; б) наличие у нее импульса ($-\mathbf{q}$) отдачи несущественно (что связано с бесконечной эффективной массой); в) температурными эффектами и шириной внутреннего уровня пренебрегаем.

Пусть основное состояние описывается вектором $|0\rangle$ (внутренняя оболочка атома заполнена), тогда, используя (7), для $\Pi(\mathbf{q}, t)$ получим

$$\Pi(\mathbf{q}, t) = \sum_{\mathbf{p}, \mathbf{p}'} M_{\mathbf{p}}^*(-\mathbf{q}) M_{\mathbf{p}'}(-\mathbf{q}) \langle 0 | b^{\dagger}(t) a_{\mathbf{p}}(t) a_{\mathbf{p}'}^{\dagger}(0) b(0) | 0 \rangle +$$

$$\begin{aligned}
 & + \sum_{pp'} \int d^3x' \exp(-i \mathbf{q} \mathbf{x}) \psi_p(\mathbf{x}) \psi_{p'}(\mathbf{x}) \int d^3x' \exp(i \mathbf{q} \mathbf{x}') |\Phi(\mathbf{x}')|^2 \times \\
 & \times \langle 0 | a_p^+(t) a_{p'}(t) b^+(0) b(0) | 0 \rangle + \sum_{p_1 p_2 p_3 p_4} \int d^3x \exp(-i \mathbf{q} \mathbf{x}) \times \\
 & \times \psi_{p_1}^*(\mathbf{x}) \psi_{p_2}(\mathbf{x}) \int d^3x' \exp(i \mathbf{q} \mathbf{x}') \psi_{p_3}^*(\mathbf{x}') \psi_{p_4}(\mathbf{x}') \times \\
 & \times \langle 0 | a_{p_1}^+(t) a_{p_2}(t) a_{p_3}^+(0) a_{p_4}(0) | 0 \rangle, \tag{9}
 \end{aligned}$$

где $a(t)$, $b(t)$ — операторы электронов в представлении Гейзенберга. Первый член в выражении (9) описывает переход с атомного уровня в зону проводимости, второй и третий члены описывают флуктуации фона. В дальнейшем мы ограничимся первым членом в выражении (9). Легко показать, что

$$\Pi(\mathbf{q}, t) = \sum_{pp'} M_p^*(-\mathbf{q}) M_{p'}(-\mathbf{q}) G_{pp'}(t), \tag{10}$$

где

$$G_{pp'}(t) = \langle 0 | T \{ b^+(t) a_p(t) a_{p'}^+(0) b(0) \} | 0 \rangle$$

причинная двухчастичная функция Грина (в канале электрон зоны проводимости — внутренняя дырка).

Окончательно для ДФФ получим соотношение

$$\begin{aligned}
 S(\mathbf{q}, \omega) &= \frac{1}{\pi} \operatorname{Re} \sum_{pp'} M_p^*(-\mathbf{q}) M_{p'}(-\mathbf{q}) \int_{-\infty}^{+\infty} dt \exp(i \omega t) G_{pp'}(t) = \\
 &= \frac{1}{\pi} \operatorname{Re} \sum_{pp'} M_p^*(-\mathbf{q}) M_{p'}(-\mathbf{q}) G_{pp'}(\omega) = \frac{1}{\pi} \operatorname{Re} \Pi(\mathbf{q}, \omega). \tag{11}
 \end{aligned}$$

Поведение функции $\Pi(\mathbf{q}, \omega)$. Следуя работе Нозьера и де Доминисса [3], матричный элемент $M_p(\mathbf{q})$ представим в виде

$$M_p(\mathbf{q}) = \sum_{lm} M_l(\mathbf{q}) U_l(\varepsilon_p) Y_{lm}(\hat{\mathbf{p}}), \tag{12}$$

где

$$U_l(\varepsilon_p) = \begin{cases} 1, & |\varepsilon_p - \varepsilon_F| < \xi_0 \\ 0, & |\varepsilon_p - \varepsilon_F| > \xi_0, \end{cases}$$

ξ_0 — фактор обрезания, ε_F — энергия Ферми. Подставляя (12) в (11), нетрудно получить

$$\operatorname{Re} \Pi(\mathbf{q}, \omega) = \sum_l (2l + 1)^2 |M_l(-\mathbf{q})|^2 G_l(\omega), \tag{13}$$

где

$$G_l(\omega) = \sum_{pp'} U_l(\varepsilon_p) \operatorname{Re} G_{pp'}(\omega) U_l(\varepsilon_{p'})$$

— спектральная функция.

В работе Нозьера и де Доминисса [3] получено асимптотическое поведение $G_l(\omega)$ при $|\xi_0 t| \gg 1$:

$$G_l(t) = L_l(t) g(t), \tag{14}$$

где

$$L_l(t) = A |i \xi_0 t|^{\frac{2\delta_l}{\pi} - 1},$$

$$g(t) = -i \theta(-t) \exp(-i \omega_0 t) |i \xi_0 t|^{-\varepsilon},$$

$$\varepsilon = 2 \sum_l (2l + 1) \left(\frac{\delta_l}{\pi}\right)^2, \quad A \sim v_0,$$

v_0 — плотность состояний вблизи границы Ферми, δ_l — разовые сдвиги рассеяния электронов зоны проводимости внутренней дыркой, $\omega_0 = \varepsilon_F - E$, E — энергия внутренней дырки.

Итак, для $G_l(t)$ получим следующее выражение:

$$G_l(t) = A \theta(-t) \exp(t \omega_0 t) |i \xi_0 t|^{\alpha_l - 1}, \quad (15)$$

где $\alpha_l = \frac{2\delta_l}{\pi} - \varepsilon$ — показатель Нозьера — де Доминисиса. Из (15) для спектральной функции $G_l(\omega)$ получим

$$G_l(\omega) = A_l \left| \frac{\xi_0}{\omega - \omega_0} \right|^{\alpha_l} \theta(\omega - \omega_0), \quad (16)$$

где

$$A_l = A \Gamma(\alpha_l).$$

Окончательно получим для $\Pi(\mathbf{q}, \omega)$ следующее выражение:

$$\Pi(\mathbf{q}, \omega) = \sum_l (2l + 1)^2 A_l |M_l(-\mathbf{q})|^2 \left| \frac{\xi_0}{\omega - \omega_0} \right|^{\alpha_l} \theta(\omega - \omega_0). \quad (17)$$

Во-первых, следует отметить, что выражение (17) для $\Pi(\mathbf{q}, \omega)$ критически зависит от знака α_l ; во-вторых, в выражение (17) входит величина $|M_l(-\mathbf{q})|^2$, которая зависит от q . При $E \gg \omega q$ практически не зависит от ω , поэтому основная зависимость $\Pi(\mathbf{q}, \omega)$ от ω определяется членом $\left| \frac{\xi_0}{\omega - \omega_0} \right|^{\alpha_l}$. Для вероятности процесса (e, e'), определяемого соотношением (1), получим

$$W(\mathbf{q}, \omega) = 32\pi^2 e^4 \text{Re} \sum_l (2l + 1)^2 A_l f_l(q) \left| \frac{\xi_0}{\omega - \omega_0} \right|^{\alpha_l} \theta(\omega - \omega_0). \quad (18)$$

Для данного значения q функция $f_l(q)$ определяет, какие значения l дают основной вклад в $W(\mathbf{q}, \omega)$. Соответствующие значения α_l легко получить, вычисляя фазы δ_l и учитывая правило Фриделя

$$2 \sum_l (2l + 1) \frac{\delta_l}{\pi} = 1.$$

Выражение (18) для $W(\mathbf{q}, \omega)$ строго имеет физический смысл для значений ω вблизи порога ω_0 . Вдали от порога ω_0 полученное выражение (18) становится несправедливым. Для получения выражения $W(\mathbf{q}, \omega)$, справедливого во всей области частот спектра, требуется найти поведение $G_l(t)$ для $|\xi_0 t| \gg 1$. Недавно Махану [4] удалось получить более общее выражение для $G_l(t)$:

$$G_l(t) = A_l \theta(-t) \exp(-i \omega_0 t) |1 + i \xi_0 t|^{\alpha_l - 1}, \quad (19)$$

которое совпадает с прежним выражением (15) при $|\xi_0 t| \gg 1$.

Из (19) нетрудно получить

$$G_l(\omega) = B_l \exp\left(-\frac{\omega - \omega_0}{\xi_0}\right) \left|\frac{\xi_0}{\omega - \omega_0}\right|^{\alpha_l} \theta(\omega - \omega_0). \quad (20)$$

Используя (20), для $W(\mathbf{q}, \omega)$ получим обобщенное выражение, справедливое по всему диапазону частот спектра:

$$W(\mathbf{q}, \omega) = 32\pi^2 e^4 \operatorname{Re} \sum_l (2l + 1)^2 B_l f_l(q) \exp\left(-\frac{\omega - \omega_0}{\xi_0}\right) \times \\ \times \left|\frac{\xi_0}{\omega - \omega_0}\right|^{\alpha_l} \theta(\omega - \omega_0). \quad (21)$$

Исследование функции $f_l(q)$. Функция $f_l(q)$ определяется соотношением

$$f_l(q) = \frac{1}{q^4} |M_l(-\mathbf{q})|^2, \quad (22)$$

$f_l(q)$ определяет относительные вклады в $W(\mathbf{q}, \omega)$ от различных значений l .

Разложим $M_p(\mathbf{q})$ по сферическим функциям. Для этого необходимо определить волновую функцию $\Phi(\mathbf{x})$ внутренней дырки. Предположим, что внутренний уровень описывается как S -состояние (например, для Li, Be) [11]:

$$\Phi(r) = \left[\frac{\lambda^3}{\pi}\right]^{1/2} \exp(-\lambda r), \quad (23)$$

где $1/\lambda$ — длина экранирования. Функция $\psi_p(\mathbf{x})$ для электронов зоны проводимости выбирается в виде

$$\psi_p(\mathbf{x}) = \exp(i\mathbf{p}\mathbf{x}) - \Phi^*(\mathbf{p})\Phi(\mathbf{x}), \quad (24)$$

где $\Phi(\mathbf{p})$ — фурье-образ функции $\Phi(\mathbf{x})$.

Итак, после несложных преобразований получим

$$M_p(\mathbf{q}) = (4\pi)^{3/2} \sum_l \{(-i)^{2l} (2l + 1)^{1/2} B_l(q) - \Phi(\mathbf{p}) A(\mathbf{q}) \delta_{l0}\} Y_{l0}(\hat{\mathbf{q}}), \quad (25)$$

где

$$B_l(q) = \int_0^\infty r^2 dr \Phi(r) j_l(qr) j_l(pr),$$

$$A_q = \int_0^\infty r^2 dr |\Phi(r)|^2 j_0(qr).$$

При $p = p_F$ имеем

$$M_l(q) = (4\pi)^{3/2} \{(i)^{2l} (2l + 1)^{1/2} B_l(q) - \delta_{l0} \Phi(p_F) A(q)\}. \quad (26)$$

Для $f_l(q)$ соответственно получим

$$f_l(q) = (4\pi)^3 \left| (-i)^{2l} (2l + 1)^{1/2} \frac{B_l(q)}{q^2} - \delta_{l0} \Phi(p_F) \frac{A(q)}{q^2} \right|^2. \quad (27)$$

Для первых значений $l = 0, 1, 2$ получим

$$f_0^{\uparrow}(q) = 256 \pi^2 \lambda^5 \left| \frac{1}{[\lambda^2 + (p_F - q)^2] [\lambda^2 + (p_F + q)^2] q^2} - \frac{16\lambda^4}{[\lambda^2 + p_F^2]^2 [4\lambda^2 + q^2]^2 q^2} \right|^2,$$

$$f_1(q) = \frac{192 \pi^2 \lambda^5}{p_F^2} \left| \frac{1}{4 p_F q^4} \ln \left| \frac{\lambda^2 + (q + p_F)^2}{\lambda^2 + (q - p_F)^2} \right| - \frac{\lambda^2 + p_F^2 + q^2}{q^3 [\lambda^2 + (q - p_F)^2] [\lambda^2 + (q + p_F)^2]} \right|^2$$

$$f_2(q) \simeq \frac{5 \cdot 10^3 \pi^2 p_F^4}{\lambda^2} \left[1 - \frac{4 p_F^2}{\lambda^2} \right]. \quad (28)$$

Из выражений (28) видно, что функции f_0 и f_1 значительно больше f_2 (аналогичное утверждение имеет место для $l=3, 4, \dots$ и т. д.). Нетрудно показать, что

$$\lim_{q \rightarrow 0} f_0(q) = \frac{64 \pi^2 \lambda^5}{(\lambda^2 + p_F^2)^4} \left[\frac{1}{2 \lambda^2} - \frac{2(1 + p_F)}{\lambda^2 + p_F^2} \right]. \quad (29)$$

$$\lim_{q \rightarrow 0} f_1(q) \rightarrow \infty$$

Из (29) видно, что при $q \approx 0$ основной вклад определяется $l=1$, а для $q > 0 - l=0$. Полученные результаты согласуются с выводами, сделанными при исследовании рассеяния рентгеновских лучей в металлах [12].

В работе получено обобщенное выражение для вероятности процесса (e, e') с возбуждением внутреннего электрона, справедливое в широком диапазоне частот спектра (не только у края поглощения). Полученная формула для (21) $W(\mathbf{q}, \omega)$ показывает, что вероятность процесса (e, e') критически зависит от знака показателя α_l , причем вклады от различных l определяются функцией $f_l(q)$. На основании данных работы [11] для простых металлов (Li, Be, Na и т. д.) получим $\alpha_l > 0$, $\alpha_l < 0$ при $l \geq 1$. Следовательно, при изменении угла рассеяния θ для процесса (e, e') (например Li) должно наблюдаться резкое изменение в спектре рассеянных электронов: для $\theta \approx 0$ ($q \approx 0$) — нулевое значение у порога ω_0 ($\alpha_l > 0$), для значений $\theta \gg 0$ — сингулярное поведение у порога ω_0 ($\alpha_l > 0$). В этой связи особенно интересны эксперименты по (e, e') [7].

ЛИТЕРАТУРА

1. Anderson P. «Phys. Rev. Lett.», 1967, 18, 1049.
2. Mahan G. «Phys. Rev.», 1967, 163, 612.
3. Nozieres P., de Dominicis C. «Phys. Rev.», 1969, 178, 1097.
4. Mahan G. «Phys. Rev.», 1975, B11, 4814.
5. Ritsko J., Schanatterly S., Gibbons P. «Phys. Rev.», 1974, B10, 5017.
6. Slusky Susan, Gibbons P., Schanatterly S., Fields J. «Phys. Rev. Lett.», 1976, 36, 326.
7. Gibbons P., Schanatterly S., Ritsko J., Fields J. «Phys. Rev.», 1976, B13, 245.
8. Pines D. «Rev. Mod. Phys.», 1956, 28, 184.
9. Nozieres P., Pines D. «Phys. Rev.», 1959, 113, 1254.
10. Pines D. Elementary Excitations in Solids, N. Y., 1963.
11. Ausman G., Glick A. «Phys. Rev.», 1969, 183, 687.
12. Doniach S., Platzman P., Yue T. «Phys. Rev.», 1971, B4, 3345.

Поступила в редакцию
22.7 1977 г.
НИИЯФ